

Содержание

● XXIII Международный симпозиум „Нанопизика и наноэлектроника“, Нижний Новгород, 11–14 марта 2019 г.

Востоков Н.В., Данильцев В.М., Краев С.А., Крюков В.Л., Скороходов Е.В., Стрельченко С.С., Шашкин В.И.

Вертикальный полевой транзистор с управляющим p – n -переходом на основе GaAs 1311

Гинзбург Н.С., Песков Н.Ю., Заславский В.Ю., Кочаровская Е.Р., Малкин А.М., Сергеев А.С., Барышев В.Р., Проявин М.Д., Соболев Д.И.

Двумерные брэгговские резонаторы на основе планарных диэлектрических волноводов (от теории к модельному тестированию) 1315

Кочаровский Вл.В., Кукушкин В.А., Тарасов С.В., Кочаровская Е.Р., Кочаровский В.В.

Асимметричная генерация в сверхизлучающем лазере с симметричным низкодобротным резонатором 1321

Кочаровская Е.Р., Мишин А.В., Рябинин И.С., Кочаровский В.В.

Особенности одновременной генерации низко- и высокодобротных мод в гетеролазерах на квантовых точках с большим временем некогерентной релаксации оптических дипольных колебаний 1329

Деребезов И.А., Гайслер В.А., Гайслер А.В., Дмитриев Д.В., Торопов А.И., von Helversen M., de la Haye C., Bounouar S., Reitzenstein S.

Неклассические источники света на основе селективно позиционированных микролинзовых структур и (111) In(Ga)As квантовых точек 1338

Кулаковский В.Д., Деменев А.А.

Динамика когерентности экситон-поляритонной системы в GaAs-микрорезонаторах при импульсном резонансном фотовозбуждении 1343

Морозов К.М., Белоновский А.В., Иванов К.А., Гиршова Е.И., Калитеевский М.А.

Взаимодействие таммовского плазмона и экситона в органическом материале в режиме сильной связи 1349

Новиков А.В., Юрасов Д.В., Байдакова Н.А., Бушуйкин П.А., Андреев Б.А., Юнин П.А., Дроздов М.Н., Яблонский А.Н., Калинин М.А., Красильник З.Ф.

Сравнительный анализ люминесценции слоев Ge:Sb, выращенных на подложках Ge(001) и Si(001) 1354

Юрасов Д.В., Байдакова Н.А., Вербус В.А., Гусев Н.С., Машин А.И., Морозова Е.Е., Нежданов А.В., Новиков А.В., Скороходов Е.В., Шенгуров Д.В., Яблонский А.Н.

Локально деформированные структуры Ge/SOI с улучшенным теплоотводом как активная среда для кремниевой оптоэлектроники 1360

Смагина Ж.В., Зиновьев В.А., Родякина Е.Е., Фомин Б.И., Степихова М.В., Яблонский А.Н., Гусев С.А., Новиков А.В., Двуреченский А.В.

Упорядоченные массивы квантовых точек Ge(Si), встроенные в двумерные фотонные кристаллы 1366

Цыпленков В.В., Шастин В.Н.

Внутрицентровая релаксация мелких доноров сурьмы в деформированном германии 1372

Бекин Н.А.

Двухфононная релаксация возбужденных состояний акцепторов бора в алмазе 1378

Архипова Е.А., Демидов Е.В., Дроздов М.Н., Краев С.А., Шашкин В.И., Лобаев М.А., Вихарев А.Л., Горбачев А.М., Радищев Д.Б., Исаев В.А., Богданов С.А.

Омические контакты к эпитаксиальным структурам CVD-алмаза с дельта-слоями бора 1386

Шоболова Т.А., Коротков А.В., Петрякова Е.В., Липатников А.В., Пузанов А.С., Оболенский С.В., Козлов В.А.

Сравнение радиационной стойкости перспективных биполярных и гетеробиполярных транзисторов 1391

Андреев Б.А., Лобанов Д.Н., Красильникова Л.В., Бушуйкин П.А., Яблонский А.Н., Новиков А.В., Давыдов В.Ю., Юнин П.А., Калинин М.И., Скороходов Е.В., Красильник З.Ф.

Излучательные свойства сильно легированных эпитаксиальных слоев нитрида индия 1395

Спирин К.Е., Гапонова Д.М., Гавриленко В.И., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А.

Спектры остаточной фотопроводимости в гетероструктурах с квантовыми ямами HgTe/CdHgTe 1401

● Электронные свойства полупроводников

Алексеев П.С.

Магнитозвуковые волны в двумерной электронной фермижидкости 1405

Вейнгер А.И., Кочман И.В., Фролов Д.А., Окулов В.И., Говоркова Т.Е., Паранчич Л.Д.

Микроволновое магнитопоглощение в HgSe с примесью Co и Ni 1413

● **Поверхность, границы раздела, тонкие пленки**

Заводинский В.Г., Кузьменко А.П.

Электронные состояния наносистем на основе сульфида кадмия в форме сфалерита 1419

Прасолов Н.Д., Гуткин А.А., Брунков П.Н.

Моделирование с помощью молекулярной динамики низкотемпературной реконструкции поверхности (001) GaAs в процессе наноиндентирования 1424

● **Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Шутаев В.А., Сидоров В.Г., Гребенщикова Е.А., Власов Л.К., Пивоварова А.А., Яковлев Ю.П.

Влияние водорода на электрические свойства структур Pd/InP 1427

● **Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники**

Соболев М.М., Явсин Д.А., Гуревич С.А.

Влияние эффекта перколяции на температурные зависимости вольт-фарадных характеристик гетероструктур на основе композитных слоев наночастиц кремния и золота . . . 1431

● **Углеродные системы**

Кукушкин В.А.

Резкое уменьшение подвижности дырок при снижении внешним напряжением их двумерной концентрации в дельта-допированных бором слоях алмаза 1437

● **Физика полупроводниковых приборов**

Гордеев Н.Ю., Паюсов А.С., Максимов М.В.

Полупроводниковая лазерная квазирешетка с фазированными одномодовыми каналами излучения 1444

Лебедев А.А., Козловский В.В., Иванов П.А., Левинштейн М.Е., Зубов А.В.

Влияние облучения электронами высокой энергии на характеристики ударных токов высоковольтных интегрированных 4H-SiC *p-n*-диодов Шоттки 1448